II.2 Tabel Perbandingan Pustaka

Tabel II.1 Tinjauan Pustaka

No.	Tahun	Judul	Nama Pengarang	Spesifikasi
1.	2018	Rancang Bangun Penguat Daya 1-Tingkat untuk Aplikasi Radar FM CW	Opik Taufik	 Frekuensi kerja: 9.3 GHz Gain: 5.029 dB VSWR input 1.041 dan
2.	2016	Perancangan dan Realisasi Penguat Daya pada Frekuensi S-Band untuk Radar Pengawas Pantai	Bilqisthi Mulyadi	 Frekuensi kerja: 2.9 GHz Gain: 30 dB VSWR: 1.009 Transistor Gali-84+ PCB Roger Duroid 5870 er: 2.3 Impedansi input dan output: 50 Ohm

3.	2015	Penguat RF Dua Tingkat pada Frekuensi 3 GHz dengan Mengunakan Penyesuai Impedansi Stub Ganda untuk Aplikasi Radar S-Band	Risman Abdul Rozak	 Frekuensi kerja: 3 GHz Bandwidth: 60 MHz VSWR: < 1.5 Gain: 22 dB PCB Roger Duroid 580 ɛr: 2.2 Impedansi input dan output: 50 Ohm Transistor ATF-551M4 dan BPF740FESD
4.	2015	Perancangan dan Realisasi Penguat Daya pada Frekuensi 1.265 – 1.275 GHz untuk Synthetic Aperture Radar	Hanimaulia	 Frekuensi kerja: 1.265 – 1.275 GHz Impedansi input dan output: 50 Ohm Gain: 6.73 dB Transistor Gali-74+ PCB FR4 & ET: 4.3 VSWR: 1.471
5.	2014	Design and Development of C-Band Microwave Amplifier for Wireless Applications	Abdulrahman S. M. dan Jamlos Alqadami	Frekuensi kerja: 5.8 GHz

				Impedansi input dan output:50 OhmGain: 12.39 dB
				Transistor ATF-55143
				Frekuensi kerja: 3 GHz
	2014			Transistor CGH40006S
		Desain dan Realisasi High Gain Power		Impedansi input dan output:
6.		Amplifier pada Pita Frekuensi 3 GHz Untuk	Wildan Naufal	50 Ohm
		Aplikasi Sistem Radar		• Gain: 14.481 dB
				PCB Roger Duroid 4000CB
				er: 3.4
				Frekuensi kerja: 7.23 GHz
				Transistor FPD6836P70
	2011			Impedansi input dan output:
7.		Development of A Single Stage C-Band Pulsed	Santu Kumar Giri dan	50 Ohm
/.		Power Amplifier for Radar Transmitter	Soumen Mandal	• Gain: 10.31 dB
				Bandwidth: 200 MHz
				• PCB Roger Duroid 5880 er:
				2.2

				•	Frekuensi kerja: 6 GHz
		Monolithic integrated C-band low noise		•	Gain: 10.8 dB
8.	2005	amplifier using AlGaN/graded-AlGaN/GaN	Zhiqun Cheng	•	Noise Figure: 2.7 dB
		HEMTs		•	Transistor 1x100µm
					CGHMET